

RA ファミリ, R8C/36M グループ

R8C から RA ファミリへの置き換えガイド フラッシュメモリ編

要旨

本アプリケーションノートは、R8C/36M グループのフラッシュメモリから RA ファミリのフラッシュメモリへの置き換えについて説明しています。

本アプリケーションノートでは、R8C/36M グループと性能が近い RA2L1 グループのフラッシュメモリと比較します。

RA2L1 グループ以外の製品のご使用を検討される場合は、各 RA 製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照ください。

対象デバイス

RA2L1 グループ, R8C/36M グループ

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

目次

1. R8C ファミリと RA ファミリのフラッシュメモリ	3
1.1 R8C/36M グループと RA2L1 グループのフラッシュメモリの書き換え	4
1.1.1 R8C/36M グループのフラッシュメモリの書き換え	4
1.1.2 RA2L1 グループのフラッシュメモリの書き換え	6
1.2 R8C/36M グループと RA2L1 グループのフラッシュメモリの相違点	8
2. 参考ドキュメント	11
改訂記録	12

1. R8C ファミリと RA ファミリのフラッシュメモリ

R8C/36M グループと RA2L1 グループでは、フラッシュメモリ機能が異なります。そのため、本アプリケーションノートでは、R8C/36M グループから RA2L1 グループへ移行する場合の参考情報を次のページ以降に掲載します。

なお、本アプリケーションノートではフラッシュメモリの仕様概要のみを説明しており、フラッシュメモリの使用方法の詳細については各ユーザーズマニュアルおよびアプリケーションノートで確認してください。

1.1 R8C/36M グループと RA2L1 グループのフラッシュメモリの書き換え

1.1.1 R8C/36M グループのフラッシュメモリの書き換え

図 1.1 に R8C/36M グループのフラッシュメモリの配置(概要)を示します。

表 1.1 に R8C/36M グループのフラッシュメモリ書き換えモード(概要)を示します。

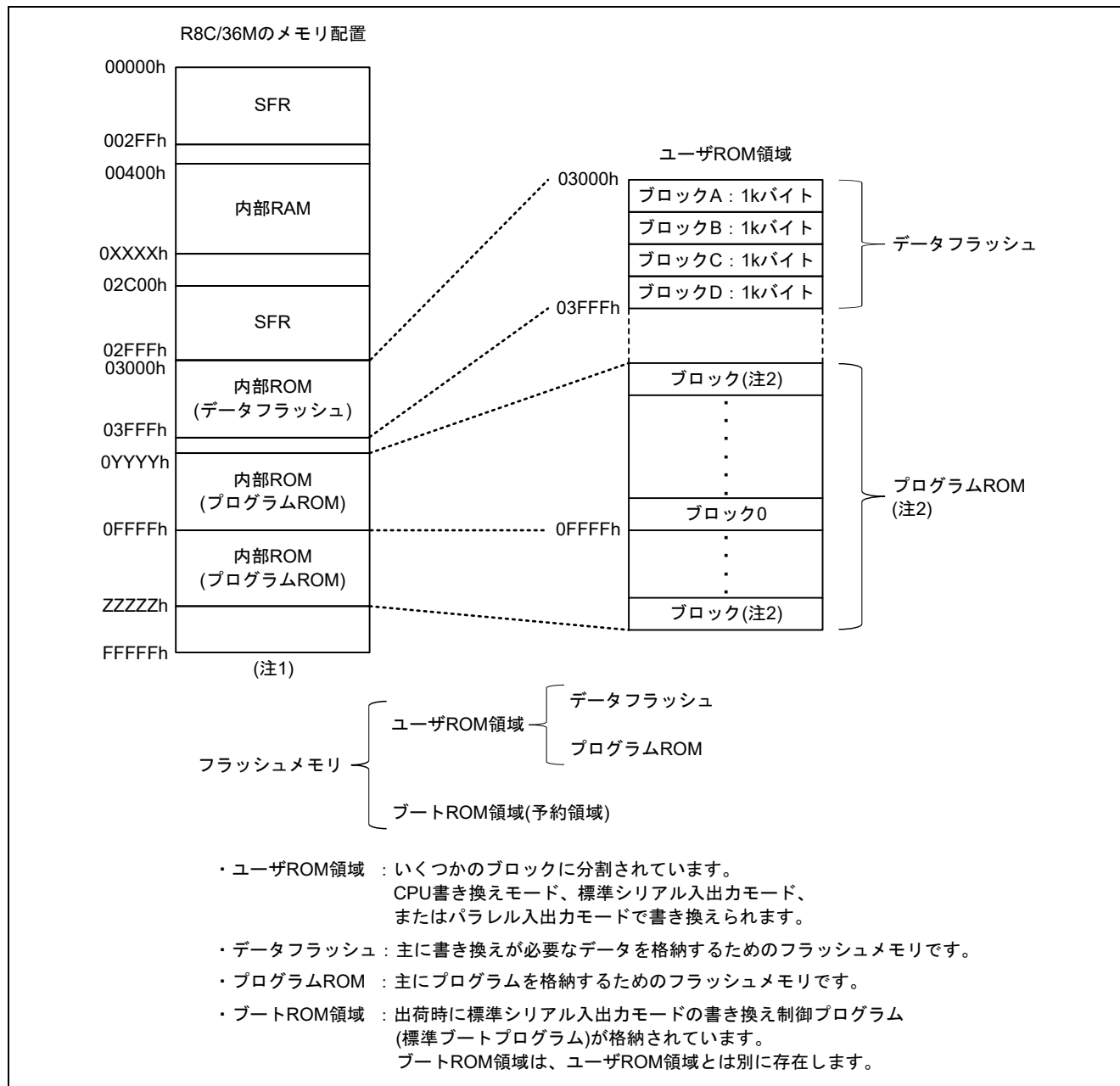


図 1.1 R8C/36M グループのフラッシュメモリの配置(概要)

注 1. 製品によって 0XXXXh、0YYYYh および ZZZZZh 番地の値が異なります。詳細は、ユーザーズマニュアルの「R8C/36M グループのメモリ配置図」を参照してください。

注 2. 製品によってブロック数およびブロックの分割(容量とアドレス値)が異なります。詳細は、ユーザーズマニュアルの「R8C/36M グループのフラッシュメモリのブロック図」を参照してください。

表 1.1 R8C/36M グループのフラッシュメモリ書き換えモード(概要)

R8C/36M グループのフラッシュメモリ書き換えモード	
動作モード	機能
CPU 書き換えモード	<ul style="list-style-type: none"> 書き換えできる領域：ユーザ ROM 書き換えに使用するプログラム：ユーザプログラム CPU がソフトウェアコマンドを実行することにより、ユーザ ROM 領域を書き換えることができます。 したがって、シリアルライタなどを使用せずにマイクロコンピュータを基板に実装した状態で、ユーザ ROM 領域を書き換えることができます。
標準シリアル入出力モード	<ul style="list-style-type: none"> 書き換えできる領域：ユーザ ROM 書き換えに使用するプログラム：標準ブートプログラム ご使用のマイコンに対応したシリアルライタを使用して、マイコンを基板に実装した状態で、ユーザ ROM 領域を書き換えることができます。(注 1)
パラレル入出力モード	<ul style="list-style-type: none"> 書き換えできる領域：ユーザ ROM 書き換えに使用するプログラム：- 専用パラレルライタを使用してユーザ ROM 領域を書き換えることができます (ご使用については、パラレルライタのメーカー様にお問い合わせください)。

注 1. 専用のシリアルライタは、E8a エミュレータ、E1 エミュレータ、書き込みツール「Flash Development Toolkit (FDT)」を使用した書き込みなどです。詳細は、各シリアルライタのマニュアルを参照してください。また、お客様で開発した R8C/3x グループ用のシリアルライタを使用することも可能です。

1.1.2 RA2L1 グループのフラッシュメモリの書き換え

図 1.2 に RA2L1 グループのメモリ配置(概要)を示します。

表 1.2 に RA2L1 グループのフラッシュメモリのプログラミング方法(概要)を示します。

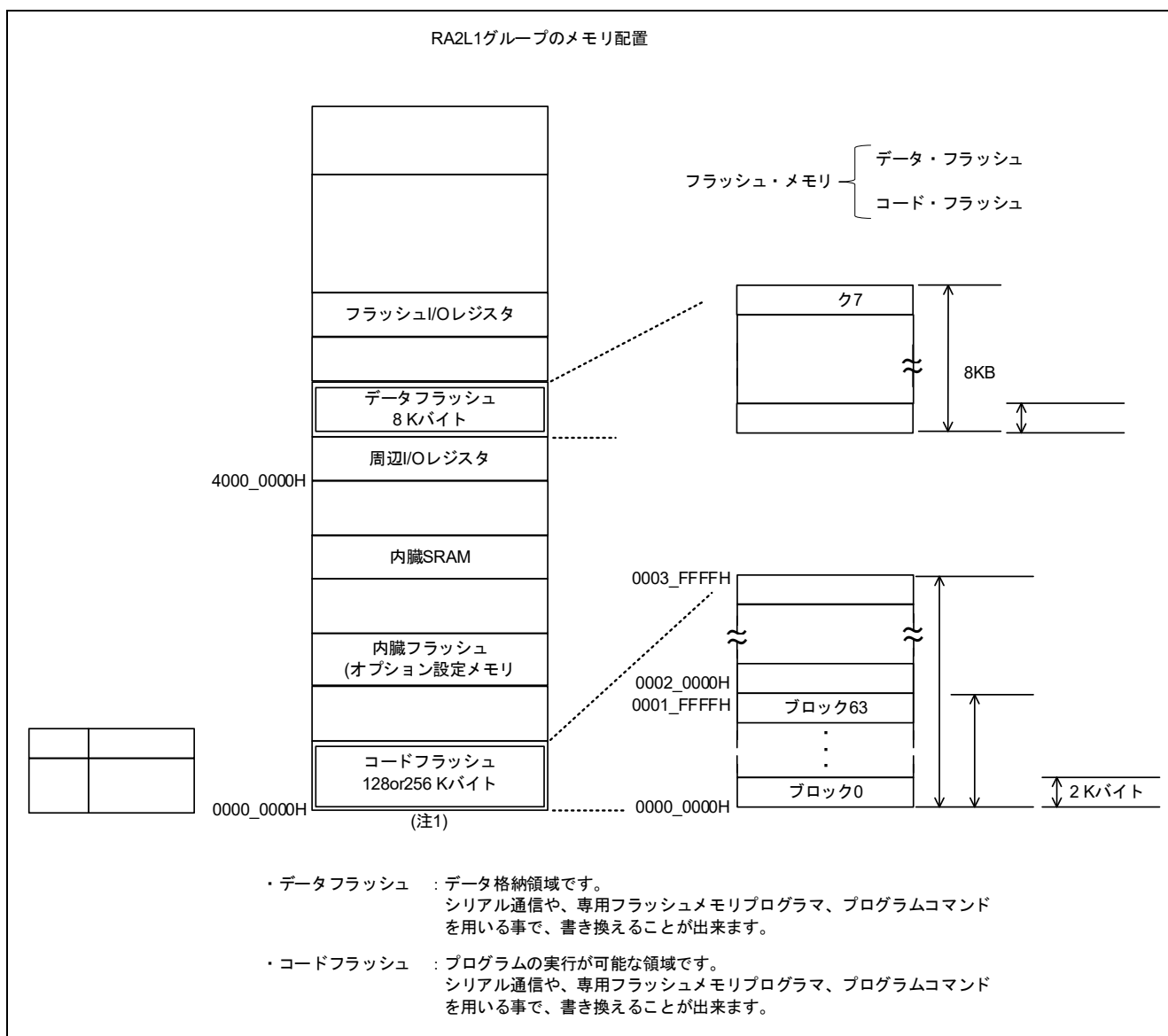


図 1.2 RA2L1 グループのメモリ配置(概要)

注 1. 製品によってコードフラッシュの容量とアドレス値が異なります。

メモリの配置の詳細については、ユーザーズマニュアルの図 4.1「メモリ・マップ」を参照してください。

注 2. フラッシュメモリは、ブロックごとに分かれています。また、製品によってコードフラッシュのブロック数が異なります。

(コードフラッシュの1ブロック=2Kバイト、データフラッシュの1ブロック=1Kバイト)

アドレス値とブロック番号の詳細については、ユーザーズマニュアルの「37.2 メモリ構造」を参照してください。

表 1.2 RA2L1 グループのフラッシュメモリのプログラミング方法(概要)

RA2L1 グループのフラッシュメモリのプログラミング方法		
プログラミング方法		機能
ユーザプログラムでのフラッシュメモリの書き換え	プログラムコマンドを使用したプログラミング	プログラムコマンドを利用することにより、ユーザプログラムでコードフラッシュを書き換えることができます。 詳細は、下記の資料を参照してください。 ・ RA2L1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編(R01UH0853JJ)
UART 通信によるフラッシュメモリの書き換え	フラッシュメモリプログラマによるシリアルプログラミング	専用フラッシュメモリプログラマ(注 1)を使用して、オンボード上でフラッシュメモリを書き換えることができます。
	外部デバイス(UART 内蔵)によるシリアルプログラミング(SCI ブート)	外部デバイス(マイコンや ASIC)との UART 通信を使用してオンボード上でフラッシュメモリを書き換えることができます。 詳細は、下記の資料を参照してください。 ・ RA2L1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編(R01UH0853JJ)

注 1. 専用フラッシュメモリプログラマは、PG-FP6、E2 オンチップデバッグエミュレータ、書き込みツール「Renesas Flash Programmer (RFP)」を使用した書き込みなどです。詳細は、各フラッシュメモリプログラマのマニュアルを参照してください。

1.2 R8C/36M グループと RA2L1 グループのフラッシュメモリの相違点

表 1.3 に R8C/36M グループと RA2L1 グループのフラッシュメモリ書き換え方法の相違点を示します。

表 1.4 にフラッシュメモリに関する相違点(概要)を示します。

表 1.3 R8C/36M グループと RA2L1 グループのフラッシュメモリ書き換え方法の相違点(1/2)

項目	R8C/36M グループ	RA2L1 グループ
ユーザプログラムでのフラッシュメモリの書き換え	CPU 書き換えモード <ul style="list-style-type: none"> • EW0 モード • EW1 モード 	<ul style="list-style-type: none"> • プログラムコマンドを使用したプログラミング
UART 通信によるフラッシュメモリの書き換え	標準シリアル入出力モード <ul style="list-style-type: none"> • 標準シリアル入出力モード 2 (2 線 UART) • 標準シリアル入出力モード 3 (単線 UART) 	<ul style="list-style-type: none"> • 専用フラッシュメモリプログラマを使用した、シリアルプログラミングモードでのプログラム • 外部デバイス(UART 内蔵)によるシリアルプログラミング
パラレルライタを使用したフラッシュメモリの書き換え	<ul style="list-style-type: none"> • パラレル入出力モード 	-

表 1.3 R8C/36M グループと RA2L1 グループのフラッシュメモリ書き換え方法の相違点(2/2)

項目	R8C/36M グループ	RA2L1 グループ
プログラム、イレーズ制御方式	[CPU 書き換えモードの場合] ソフトウェアコマンドによる プログラム、イレーズ制御	[プログラムコマンドを使用したプログラミング] プログラムコマンドの使用による フラッシュメモリの書き換え
	[標準シリアル入出力モードの場合] 制御コマンドの送信による プログラム、イレーズ制御	[フラッシュメモリプログラマ によるシリアルプログラミング/ 外部デバイス(UART 内蔵)による シリアルプログラミングの場合] 制御コマンドやプログラミングデータ 送信による プログラム、イレーズ制御
プログラム方式	[CPU 書き換えモードの場合] 1 バイト単位での書き込み	[コードフラッシュの場合] 32 ビット単位での書き込み
	[標準シリアル入出力モードの場合] 「1 バイト単位×n(データ数)」 または 256 バイト単位での書き込み	[データフラッシュの場合] 8 ビット単位での書き込み
イレーズ方式	ブロック単位での消去 (データフラッシュは、 1 ブロック = 1 K バイト単位。 プログラム ROM は、 各製品で各ブロックの容量が異なる)	ブロック単位での消去 [コードフラッシュの場合] 1 ブロック = 2K バイト単位 [データフラッシュの場合] 1 ブロック = 1 K バイト単位

表 1.4 フラッシュメモリに関する相違点(概要)

項目		R8C/36M グループ	RA2L1 グループ
プログラム、イレーズ電圧		$V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$ (動作周囲温度(T_{opr}) = $0 \sim 60^{\circ}C$)	• $V_{CC} = 1.6 \sim 5.5V$ (動作周囲温度(T_A) = $-40 \sim +85^{\circ}C$)
プログラム、イレーズ回数	プログラムROM / コード・フラッシュ	1,000 回	1,000 回
	データフラッシュ / データ・フラッシュ	10,000 回(min)	100,000 回(min)
セキュリティ機能		データ保護機能 (プログラムROMの書き換え許可/禁止設定。CPU書き換えモードに対応) ロックビットによるブロック単位での書き換えプロテクトが可能 (ロックビットの設定は、ソフトウェアコマンドで実行。 FMR13ビットでロックビットの有効/無効を設定)	フラッシュメモリの書き換え許可/禁止設定(CPU書き換えモードに対応) コードフラッシュ、データフラッシュ に関して、書き換えプロテクトが可能 (DFLCTL、FENTRYR、FPR、FPMCR レジスタにて、フラッシュ毎に書き換え許可/禁止を設定)
		データフラッシュの書き換え許可/禁止設定(CPU書き換えモードに対応) ブロック単位での書き換えプロテクトが可能(FMR1レジスタのFMR14、FMR15、FMR16、FMR17ビットで書き換への許可/禁止を設定)	
		IDコードチェック機能 (標準シリアル入出力モードに対応)	ID認証機能
		ROMコードプロテクト機能 (パラレル入出力モードに対応)	IDコードプロテクト機能 (シリアルプログラミングのみ対応)
その他の機能		<ul style="list-style-type: none"> • BGO(バックグラウンドオペレーション)機能 • イレーズサスペンド機能 	<ul style="list-style-type: none"> • BGO(バックグラウンドオペレーション)機能 • セルフプログラミング中の割り込み受付 • フラッシュメモリ拡張領域設定可能

2. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル

- RA2L1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)
- R8C/36M グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)
- テクニカルアップデート
(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ユーザーズマニュアル：開発環境

- Renesas Flexible Software Package (FSP) User' s Manual (R11UM0155EU)

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<https://www.renesas.com/>

お問合せ先

www.renesas.com/contact/

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Mar.27.24	—	初版発行

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、変更、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、変更、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

- 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限られません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレストシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。